## 特許協力条約

今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。

PCT

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人

の費類記号 146686-115



	<del></del>				
国際出願番号 PCT/JP2004/004070	国際出願日 (日. 年) 24.03.2004	優先日 (日.月.年) 25.03.2003			
国際特許分類 (IPC) Int.Cl. H01L21/31	4, 21/31				
出願人(氏名又は名称) 東京エレクトロン株式会社	,				
·					
1. この報告書は、PCT35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。 法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。					
2. この国際予備審査報告は、この表紙を	2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で3 ページからなる。				
3. この報告には次の附属物件も添付されている。 a. ♥ 附属書類は全部で ページである。					
▼ 補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面の用紙(PCT規則 70.16 及び実施細則第 607 号参照)					
「 第 I 概 4 . 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの 国際予備審査機関が認定した差替え用紙					
b. 「 電子媒体は全部で		(電子媒体の種類、数を示す)。			
配列表に関する補充概に示すよ ブルを含む。(実施細則第 802	こうに、コンピュータ読み取り可能な形式に 2 号参照)	こよる配列表又は配列表に関連するテー			
4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。					
<ul><li></li></ul>	告の基礎				
□ 第Ⅲ概 新規性、進歩性	又は産業上の利用可能性についての国際予	備審査報告の不作成			
<ul><li></li></ul>	欠如 こ規定する新規性、進歩性又は産業上の利用	    可能性についての見解、それを裏付			

国際予備審査の請求書を受理した日 25.01.2005	国際予備審査報告を作成した日 15.07.2005
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/IP)	特許庁審査官 (権限のある職員) 4R 9169
郵便番号100-8915	今井 拓也 
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3471

第VI棚 ある種の引用文献 第VII棚 国際出願の不備

第VII欄 国際出願に対する意見

けるための文献及び説明

第I橌	報告の基礎	·		
1. za	)国際予備審査報告は、	下記に示す場合を除くほか	、国際出願の言語を基礎	とした。
r	それは、次の目的で提出 PCT規則12.3及び PCT規則12.4にV	語による翻訳文を 出された翻訳文の言語であ \$23.1(b)にいう国際調査 いう国際公開 は55.3にいう国際予備審査		
2. この た差替え	の報告は下記の出願書類 と用紙は、この報告におり	を基礎とした。(法第6条 いて「出願時」とし、この	:(PCT14条)の規定に 報告に添付していない。	基づく命令に応答するために提出され ) ··
	出願時の国際出願書類	i		
V	明細書			
	第1-14	ページ、	出願時に提出されたもの	>
	第	ページ*、		が付けで国際予備審査機関が受理したもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの
		ペーシ*、		付けで国際予備審査機関が受理したもの
V	請求の範囲			
		2項、		
	第 第 1 9	項*、 原*	PCT19条の規定に基 15 06 2005	いる補正されたもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの
	第 <u></u>		13. 00. 2003	付けで国際予備審査機関が受理したもの
Δ.	•		•	
ᅜ	図面		•	
	第 <u>1/7-7/7</u>	ページ <del>/図</del> 、	出願時に提出されたもの	·
	第	ページ/図*、		イけで国際予備審査機関が受理したもの付けで国際予備審査機関が受理したもの
	弟	ページ/図*、		付けで国際予備審査機関が受理したもの
Γ.	配列表又は関連するテ			
	配列表に関する補	充欄を参照すること。		
3. 1✓.	補正により、下記の書類	<b>頚が削除された。</b>		
	厂 明細書	第	:	ぺ <b>~</b> ∵?
	▼ 請求の範囲			٩
	図面	第		ページ/図
	配列表(具体的に		·	
	配列表に関連する	テーブル(具体的に記載す	ること)	
4. T	この報告は、補充欄にえてされたものと認めら	Fしたように、この報告に oれるので、その補正がさ	添付されかつ以下に示し れなかったものとして作	た補正が出願時における開示の範囲を超 成した。 (PCT規則 70.2(c))
	<b>川</b> 明細書	第	^	・ージ
	請求の範囲			9
		第	^	<b>・・ジ</b> /図
	配列表(具体的に	記載すること) テーブル(具体的に記載す	z = L)	
	・ ロンリストに別座りる	, ノル (共予別に記載す	S-C1	
* 4. 13	:該当する場合、その用網	紙に "superseded" と記入	されることがある。	,

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第 12 条 (PCT35 条(2)) に定める見解、 それを裏付ける文献及び説明				
1. 見解				
新規性(N)	請求の範囲 1-5,9-12 有   請求の範囲 無			
進歩性(IS)	請求の範囲 1-5, 9-12 有   請求の範囲 無			
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲   1-5,9-12   有     請求の範囲   無			
2. 文献及び説明(PCT規則 7	0. 7)			
【請求項6】【請求項7】 【0151】【0166】 文献2´: JP·2002-22066 【請求項5】【0019】【0	A (東京エレクトロン株式会社) 1999 06 18			
膜がないて、ファカス とこれ では、ファカス とこれ であり、、アカス でありは、プログラ では、	「12」 「「カーボン膜(フルオロカーボン膜)を成膜するプラズマ成ズマにより電子温度3eV以下であり、かつ電子密度 $10^{12}$ / 2.7 Paとしたプラズマ成膜方法が記載されている。 「「スマ成膜方法によってフッ素添加カーボン膜を成膜する為に 「C。F。を使用する示唆が記載されている。 「C。F。を使用し、かつC。F。ガス供給孔と基板表面との間 「C。F。を使用し、かつ電子密度 $10^{12}$ / c m³以上であり、 「Sを2eV以下とし、かつ電子密度 $10^{12}$ / c m³以上であり、 95 Pa以下とし、またそのように形成されるフッ素添加カ 「95 Pa以下とし、またそのように形成されるフッ素添加カ 「タ 5 Pa以下とし、またそのように形成されるフッ素添加カ 「S 2 S 3以下でかつリーク電流が $5 \times 10^{-8}$ A $10^{-8}$ C m²で なく、また当該事項は自明なものでもない。			